

В области физики сегнетоэлектриков и диэлектриков (2010) методом расчета *ab initio* установлено, что в свободно подвешенных сверхрешетках $(\text{KNbO}_3)_1(\text{KTaO}_3)_n$ с $n=1-7$ в слоях KNbO_3 толщиной в одну элементарную ячейку возможно возникновение двумерного сегнетоэлектричества; результат перспективен для использования таких сверхрешеток для трехмерной записи информации (физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова).